

附件一

电子元器件自查承诺书

依据 ZKB 3101-001-2022《军用电子元器件自主可控评估通用准则》和 ZKB 3101-002-2024《武器装备使用国产电子元器件“伪、空、包”产品判定准则(试行)》的相关要求，我单位针对研制生产的电子元器件产品开展自主可控等级和“伪、空、包”情况自查及评估。结果如下：

自查产品共 24 项，其中自主可控 A 级 0 项、B 级 0 项、C 级 24 项、C*级 0 项、D 级 0 项、E 级 0 项；伪国产化 0 项、包装国产化 0 项、空心国产化 0 项。

电子元器件“伪、空、包”审查基本信息填写表详见附表一；电子元器件使用 IP 核情况、原材料和零部件、工艺流片等基本情况填写表详见附表二。

我单位承诺以上内容真实有效，自愿承担一切后果。

特此承诺。



2025 年 09 月 17 日

附表一

电子元器件“伪、空、包”审查信息一览表

序号	元器件名称 ^a	型号规格 ^b	生产厂商 ^c	自主可控等级 ^d	是否“伪国产化” ^e		是否“包装国产化” ^e		是否“空心国产化” ^e		备注 ^e
					是/否	情况说明	是/否	情况说明	是/否	情况说明	
1	电压基准	JTLX3012XSF3	无锡泰连芯科技有限公司	C	否	无	否	无	否	无	
2	电压基准	JTLX3018XSF3	无锡泰连芯科技有限公司	C	否	无	否	无	否	无	
3	电压基准	JTLX3020XSF3	无锡泰连芯科技有限公司	C	否	无	否	无	否	无	
4	电压基准	JTLX3025XSF3	无锡泰连芯科技有限公司	C	否	无	否	无	否	无	
5	电压基准	JTLX3030XSF3	无锡泰连芯科技有限公司	C	否	无	否	无	否	无	
6	电压基准	JTLX3033XSF3	无锡泰连芯科技有限公司	C	否	无	否	无	否	无	
7	电压基准	JTLX3040XSF3	无锡泰连芯科技有限公司	C	否	无	否	无	否	无	
8	电压基准	JTLX3045XSF3	无锡泰连芯科技有限公司	C	否	无	否	无	否	无	
9	电压基准	JTLX3012XSF3(W)	无锡泰连芯科技有限公司	C	否	无	否	无	否	无	
10	电压基准	JTLX3018XSF3(W)	无锡泰连芯科技有限公司	C	否	无	否	无	否	无	
11	电压基准	JTLX3020XSF3(W)	无锡泰连芯科技有限公司	C	否	无	否	无	否	无	
12	电压基准	JTLX3025XSF3(W)	无锡泰连芯科技有限公司	C	否	无	否	无	否	无	

填报单位（盖章）：



法定代表人（签章）：

汤景河

填表人（签字）：

姜春雷

电话：

18226090182

填报日期：20250917

13	电压基准	JTLX3030XSF3(W)	无锡泰连芯科技有限公司	C	否	无	否	无	否	无	
14	电压基准	JTLX3033XSF3(W)	无锡泰连芯科技有限公司	C	否	无	否	无	否	无	
15	电压基准	JTLX3040XSF3(W)	无锡泰连芯科技有限公司	C	否	无	否	无	否	无	
16	电压基准	JTLX3045XSF3(W)	无锡泰连芯科技有限公司	C	否	无	否	无	否	无	
17	电压基准	TLX3012XSF3	无锡泰连芯科技有限公司	C	否	无	否	无	否	无	
18	电压基准	TLX3018XSF3	无锡泰连芯科技有限公司	C	否	无	否	无	否	无	
19	电压基准	TLX3020XSF3	无锡泰连芯科技有限公司	C	否	无	否	无	否	无	
20	电压基准	TLX3025XSF3	无锡泰连芯科技有限公司	C	否	无	否	无	否	无	
21	电压基准	TLX3030XSF3	无锡泰连芯科技有限公司	C	否	无	否	无	否	无	
22	电压基准	TLX3033XSF3	无锡泰连芯科技有限公司	C	否	无	否	无	否	无	
23	电压基准	TLX3040XSF3	无锡泰连芯科技有限公司	C	否	无	否	无	否	无	
24	电压基准	TLX3045XSF3	无锡泰连芯科技有限公司	C	否	无	否	无	否	无	

填表说明：

^a. 应是元器件全称，与详细规范或产品技术资料上的名称相符；

填报单位（盖章）：



法定代表人（签章）：

填报人（签字）：

姜春雷

电话：

18226090182

填报日期：20250917

- ^b. 应填写元器件完整型号规格；
- ^c. 应填写元器件生产厂商中文全称，勿填写代理商；
- ^d. 按照 ZKB 3101-001-2022《军用电子元器件自主可控评估通用准则》执行，分为 A、B、C、C*、D、E 六个等级，针对为军选民用计算机设备等配套的中央处理器、图形处理器、网络交换芯片、网络处理器芯片、网络控制器芯片、存储控制器芯片按照 GJB 9530 执行；
- ^e. “伪、空、包”应按照 ZKB3101-002-2022 标准执行。若为“是”时，则需要在“情况说明”写明判别因素；若为“否”时，则填“无”；
- ^f. 若存在其他需要说明的情况，可在备注栏填写。



填报单位（盖章）：

法定代表人（签章）：

填表人（签字）：

姜春雷

电话：

18221090182

填报日期：20250917

附表二

电子元器件基本信息表

序号	元器件名称 ^a	型号规格 ^b	使用 IP 核情况 ^c				原材料和零部件 ^d				流片工艺 ^e		备注
			名称	类型	来源单位	境内/境外	名称	是否“核心”/“关键” ^e	来源单位 ^f	境内/境外	工艺名称	境内/境外	
1	电压基准	JTLX3012XSF3	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境内	0.18um CMOS	境内	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	南通通富				
2	电压基准	JTLX3018XSF3	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境内	0.18um CMOS	境内	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	南通通富				
3	电压基准	JTLX3020XSF3	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境内	0.18um CMOS	境内	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	南通通富				
4	电压基准	JTLX3025XSF3	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境内	0.18um CMOS	境内	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	南通通富				
5	电压基准	JTLX3030XSF3	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境内	0.18um CMOS	境内	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	南通通富				
6	电压基准	JTLX3033XSF3	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境内	0.18um CMOS	境内	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	南通通富				
7	电压基准	JTLX3040XSF3	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境内	0.18um CMOS	境内	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	南通通富				

填报单位(盖章):



法定代表人(签章):

汤景河

填表人(签字):

姜春雷

电话:

1822690182

填报日期: 20250917

8	电压基准	JTLX3045XSF3	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境内	0.18um CMOS	境内	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	南通通富				
9	电压基准	JTLX3012XSF3 (W)	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境内	0.18um CMOS	境内	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	南通通富				
10	电压基准	JTLX3018XSF3 (W)	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境内	0.18um CMOS	境内	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	南通通富				
11	电压基准	JTLX3020XSF3 (W)	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境内	0.18um CMOS	境内	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	南通通富				
12	电压基准	JTLX3025XSF3 (W)	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境内	0.18um CMOS	境内	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	南通通富				
13	电压基准	JTLX3030XSF3 (W)	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境内	0.18um CMOS	境内	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	南通通富				
14	电压基准	JTLX3033XSF3 (W)	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境内	0.18um CMOS	境内	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	南通通富				
15	电压基准	JTLX3040XSF3 (W)	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境内	0.18um CMOS	境内	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	南通通富				
16	电压基准	JTLX3045XSF3 (W)	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境内	0.18um CMOS	境内	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	南通通富				

填报单位(盖章):

法定代表人(签章):

填表人(签字):

电话:

填报日期: 20250917

17	电压基准	TLX3012XSF3	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境内	0.18um CMOS	境内	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	南通通富				
18	电压基准	TLX3018XSF3	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境内	0.18um CMOS	境内	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	南通通富				
19	电压基准	TLX3020XSF3	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境内	0.18um CMOS	境内	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	南通通富				
20	电压基准	TLX3025XSF3	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境内	0.18um CMOS	境内	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	南通通富				
21	电压基准	TLX3030XSF3	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境内	0.18um CMOS	境内	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	南通通富				
22	电压基准	TLX3033XSF3	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境内	0.18um CMOS	境内	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	南通通富				
23	电压基准	TLX3040XSF3	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境内	0.18um CMOS	境内	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	南通通富				
24	电压基准	TLX3045XSF3	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境内	0.18um CMOS	境内	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	南通通富				

填表说明:

^a. 应是元器件全称, 与详细规范或产品技术资料上的名称相符;

填报单位(盖章):



法定代表人(签章):

汤慧研

填表人(签字):

姜春雷

电话:

18226090182

填报日期: 20250917

- ^b. 应填写元器件完整型号规格；
- ^c. 仅适用于半导体集成电路，应填写 IP 核类型，包括“软核”“固核”“硬核”；
- ^d. 本表中应填报的原材料和零部件应根据实际情况填写，至少包含 ZKB 3101-002-2022 标准附录 A 中内部零部件或原材料，同时也应包含外壳、引出端、键合丝等，不包含灌封料等生产过程材料；
- ^e. 应根据 ZKB 3101-002-2022 标准附录 A 填写“核心”或“关键”，非“核心”或“关键”原材料和零部件此项不填；
- ^f. 应根据实际设计单位或生产商情况填写，不能按代理商填写；对来源不明的，应填写“来源不明”，具体判定时视为“境外”；
- ^g. 仅适用于半导体集成电路，应填写流片工艺名称，如 45nmBCD 工艺等，必要时在备注中填写流片厂商信息。



填报单位(盖章):

法定代表人(签章):

填表人(签字):

电话:

18221090182

填报日期: 20250917